

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-163466

(43)公開日 平成10年(1998) 6月19日

(51)Int.Cl.⁶

識別記号

F I

H 0 1 L 27/148

H 0 1 L 27/14

B

H 0 4 N 5/335

H 0 4 N 5/335

F

審査請求 有 請求項の数5 O L (全 7 頁)

(21)出願番号 特願平8-319471

(22)出願日 平成8年(1996)11月29日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 村上 真一

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

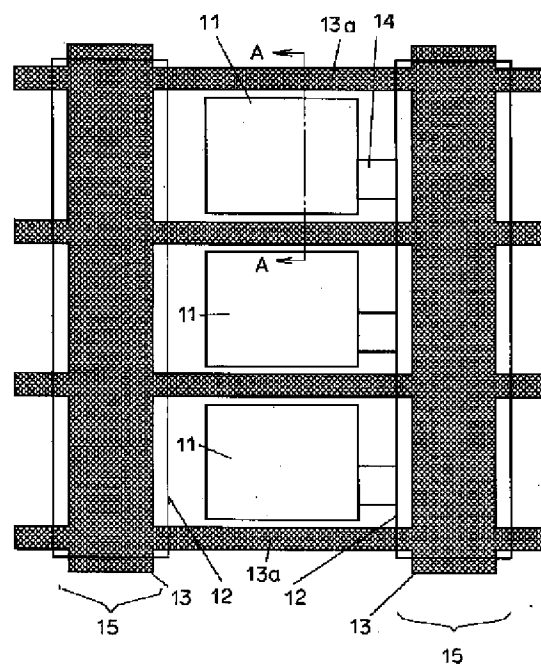
(74)代理人 弁理士 鈴木 章夫

(54)【発明の名称】 固体撮像素子

(57)【要約】

【課題】 固体撮像素子の出力信号レベルの基板電圧依存性を緩和し、システム組み込み時の基板電圧設定に余裕を持たせる。

【解決手段】 マトリクス状に配置された受光領域11と、これら受光領域11の水平転送方向の間に配設された第2のP型ウェル13とN型層12からなる垂直転送部15とを備える固体撮像素子において、垂直転送方向に隣接する受光領域11の間にP型半導体層13aを有する。このP型半導体層13aにより受光領域11の直下の低濃度P型領域を狭め、受光領域11に蓄積している電荷が基板側へ掃き出されることを抑制し、半導体基板に印加する電圧の変化に対する固体撮像素子の出力信号レベルの変化を小さくし、基板電圧の設定に余裕を持たせる。



11 : 受光領域

12 : N型層

13, 13a : 第2のP型ウェル

14 : 電荷読み出し部

15 : 垂直転送部

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一導電型の半導体層上に反対導電型の受光領域がマトリクス状に配置され、これら受光領域に蓄積される電荷を垂直転送方向に転送する垂直転送部が前記各受光領域の水平転送方向の間に配設されてなる固体撮像素子において、前記受光領域の垂直転送方向の両側に一導電型の半導体層が形成されていることを特徴とする固体撮像素子。

【請求項2】 反対導電型の半導体基板上に形成された第1の一導電型ウェルと、前記第1の一導電型のウェル上にマトリクス状に配置された反対導電型の受光領域と、前記第1の一導電型ウェル上に電荷の垂直転送方向に延在するように形成された第2の一導電型ウェルと、前記第2の一導電型ウェル上に垂直転送方向に延在するように形成されて前記第2の一導電型ウェルとで垂直転送部を構成する反対導電型層と、前記第1の一導電型ウェル上に形成されて垂直転送方向に隣接する前記受光領域の間に形成された一導電型半導体層とを備える請求項1の固体撮像素子。

【請求項3】 前記一導電型の半導体層は、受光領域の直下の一部にまで拡散されてなる請求項1または2の固体撮像素子。

【請求項4】 前記垂直転送部を形成する前記第2の一導電型ウェルと、前記受光領域の垂直転送方向に隣接する前記一導電型半導体層とが分離されてなる請求項2または3の固体撮像素子。

【請求項5】 第2の一導電型ウェルは水平転送方向に前記受光領域の直下一部にまで延長されてなる請求項2ないし4のいずれかの固体撮像素子。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【発明の属する技術分野】 本発明は固体撮像素子に関し、特にその構造に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年のCCD (Charge Coupled Device) 型固体撮像素子は主に縦型オーバーフロードレイン (以下、VODと記す) 構造を採用している。このVOD構造は受光領域で発生した余剰電荷を基板内部方向に掃き出すような構造になっており、素子の平面方向に掃き出し用のドレインを設ける必要がなく、素子の寸法を抑えられるので、固体撮像素子の構造の主流となっている。図5は従来のVOD構造の固体撮像素子の平面レイアウト図、図6はそのBB線に沿う受光領域部分の断面図である。N型の半導体基板16上に第1のP型ウェル17が形成され、その主面にN型の受光領域11が形成されている。この受光領域11に隣接するようにして第1のP型ウェル17よりも高濃度の第2のP型ウェル13とその上に形成されたN型層12からなる垂直転送部15が設けられており、受光領域11で発生した電荷は、N型の電荷読み出し部14を通して垂直転送部15

へ読み出されるようになっている。

【0003】 ここで、受光領域11で発生した電荷は光照射時間と共に受光領域に蓄積されてゆくが、蓄積電荷量が受光領域の電荷蓄積容量を越えると、その余剰電荷は隣接する垂直転送部15や受光領域11へ漏れ込み、ブルーミング現象が発生する。これを抑制するために、N型半導体基板16に正の電圧を印加し第1のP型ウェル17のポテンシャル障壁を下げることにより余剰電荷をN型基板16側へ掃き出している。また、N型半導体基板16への印加電圧を高くすると受光領域11の電荷蓄積容量が減少してゆき、ある基板電圧で受光領域の電荷蓄積容量は0になる。図7は受光領域11の電荷蓄積量の基板電圧への依存特性を示したものである。また余剰電荷を掃き出すためにN型半導体基板16へ印加する電圧は、受光領域11の直下のP型ウェル17のP型不純物の濃度によって変化する。P型不純物濃度が高くなれば、P型ウェル17によるポテンシャル障壁が大きくなるので、その障壁を下げるためにN型半導体基板16へ印加する電圧は高くなる。よって、第1のP型ウェルの不純物濃度を高くすると、受光領域直下のP型不純物濃度が一樣に高くなり、図8で示すようにP型ウェル17のポテンシャル障壁が高くなるので、受光領域11に蓄積された電荷が一樣に基板側に掃き出され難くなり、受光領域の電荷蓄積量の基板電圧依存特性は基板電圧が高い方向へ一樣にシフトする。

【0004】 一方、第2のP型ウェル13は、受光領域11の深部で光電変換して発生した電荷が受光領域11に蓄積されずに垂直転送部15へ漏れ込む現象、いわゆるスミアを防止するために、垂直転送部15の直下のP型不純物濃度が第1のP型ウェル17より高くなるように垂直転送部15の直下に形成されているが、そのイオン注入工程以降の熱処理により、実際にはマスクのパターンより受光領域11の水平転送方向両側から受光領域11の直下へ向かってP型不純物が拡散され、P型不純物濃度は受光領域直下の中央が低く、水平方向両端が実効的に高くなる。したがって、受光領域11の電荷蓄積容量の基板電圧依存特性も、第2のP型ウェル13の不純物の拡散状態により影響を受けることになる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 このような、従来の固体撮像素子に特に業務用等の高性能カメラに用いた場合、感度等の特性を確保するために、1画素の寸法をある程度の大きさ以上確保しておく必要があり、その場合、受光領域の拡大により水平転送方向の画素ピッチも広がってゆく。一方、固体撮像素子の水平転送方向の画素ピッチが広がると受光領域11の直下の中央のP型不純物濃度の低い領域17aの面積が大きくなる。この領域17aの面積が大きいほど受光領域11のP型ウェルのポテンシャル障壁の低い領域が大きくなるので受光領域11に蓄積している電荷量が基板16側へ掃き出

され易くなり、基板電圧に対する受光領域の蓄積電荷量の変化量が大きくなる。この基板電圧に対する蓄積電荷の変化量が大きすぎると、この固体撮像素子をカメラ等のセットに組み込んだ場合に基板電圧の設定範囲が狭くなり余裕がなくなるといった問題がある。また、セットの電源電圧の変動等による基板電圧の変動に対しても余裕がなくなってしまう。

【0006】ここで、第1のP型ウェル17の不純物濃度を高くして蓄積電荷を基板側へ掃き出し難くする方法も考えられるが、前述したように受光領域11の中央のP型不純物濃度の低い領域17aのポテンシャル障壁が受光領域周辺部と同時に高くなるため、蓄積電荷量の基板電圧特性は一樣に高電圧側へシフトするだけで、基板電圧に対する出力信号の変化量は小さくならない。

【0007】本発明の目的は、出力信号レベルの基板電圧依存性を緩和し、システム組み込み時の基板電圧の余裕を大きくすることを可能にした固体撮像素子を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明は、一導電型の半導体層上に反対導電型の受光領域がマトリクス状に配置され、これら受光領域に蓄積される電荷を垂直転送方向に転送する垂直転送部が前記各受光領域の水平転送方向の間に配設されてなる固体撮像素子において、前記受光領域の垂直転送方向の両側に一導電型の半導体層が形成されていることを特徴とする。例えば、反対導電型の半導体基板上に形成された第1の一導電型ウェルと、前記第1の一導電型のウェル上にマトリクス状に配置された反対導電型の受光領域と、前記第1の一導電型ウェル上に電荷の垂直転送方向に延在するように形成された第2の一導電型ウェルと、前記第2の一導電型ウェル上に垂直転送方向に延在するように形成されて前記第2の一導電型ウェルとで垂直転送部を構成する反対導電型層と、前記第1の一導電型ウェル上に形成されて垂直転送方向に隣接する前記受光領域の間に形成された一導電型半導体層とを備える構成とされる。

【0009】ここで、前記一導電型の半導体層は、受光領域の直下の一部にまで拡散された構成とされる。また、垂直転送部を形成する前記第2の一導電型ウェルと、前記受光領域の垂直転送方向に隣接する前記一導電型半導体層とが分離されていることが好ましい。

【0010】

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図1は本発明の一実施例の固体撮像素子の平面図であり、受光領域11、電荷読み出し部14、垂直転送部15を示す図である。マトリクス状に配置された受光領域11の各垂直転送列に対して、水平転送方向に隣接してN型ウェル12と第2のP型ウェル13からなる垂直転送部15が設けられており、垂直転送方向に隣接した受光領域11の間の素子分離領域の直下

にも、前記第2のP型ウェル13の一部が延長された状態で形成されており、この第2のP型ウェル13aによって受光領域11の水平転送方向の両側の各垂直転送部15を構成している各第2のP型ウェル13をそれぞれ接続するように設けられている。

【0011】図2は図1のAA線、すなわち垂直転送方向に沿う断面図である。なお、水平転送方向に沿う断面図は図6に示した従来構成とほぼ同じである。図2では、N型半導体基板16上に第1のP型ウェル17が形成され、その主面に前記受光領域11が形成され、この受光領域11を垂直転送方向に挟むように第2のP型ウェル13の一部13aを形成した構成を示している。前記したように受光領域11の垂直転送方向の両側に設けられた第2のP型ウェル13aは、熱拡散により実際のマスクパターンより受光領域11下まで広がってきている。これにより受光領域11の垂直転送方向の両端のP型不純物濃度が高くなり、受光領域中央のP型不純物濃度の低い部分17aの面積が狭くなる。よって、受光領域11に蓄積された電荷がN型半導体基板16側へ掃き出し難くなる。

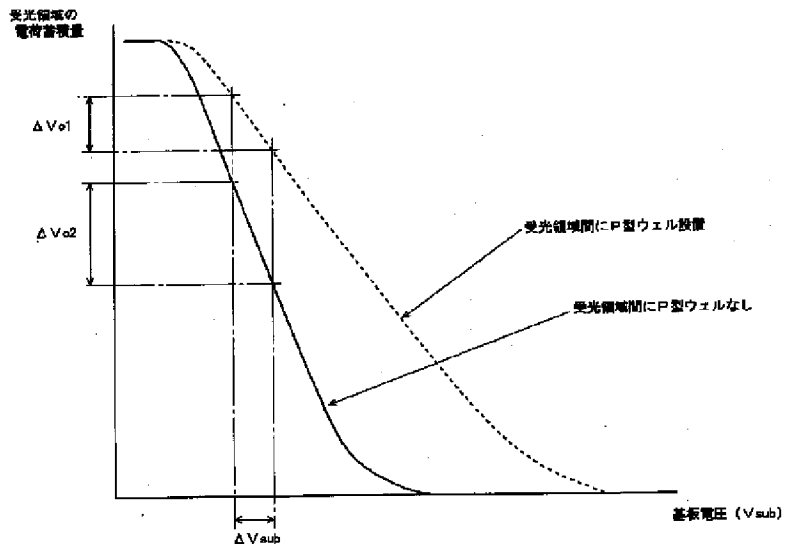
【0012】図3の破線は垂直転送方向に隣接した受光領域11の間にP型ウェル13aを形成したときの、受光領域の蓄積電荷の基板電圧への依存性を示したものである。同じ基板電圧の変化量 ΔV_{sub} に対して、受光領域の間にP型ウェルを設けたときの受光領域の蓄積電荷の変化量 ΔV_{o1} が、同図実線のP型ウェルがない場合の蓄積電荷の変化量 ΔV_{o2} より小さくなる。よって、カメラ等のセットに組み込んだ場合に、基板電圧の設定値に多少のズレが生じて出力信号の変化が小さくなるので、基板電圧範囲に余裕ができ、またセットの電源電圧の変動等による基板電圧の変動に対しても余裕ができる。

【0013】図4は本発明の第2の実施形態の固体撮像素子の平面図である。第1の実施形態で説明したように、垂直転送部15の下に設けられた第2のP型ウェル13には、受光領域11の深部で光電変換が発生し垂直転送部15へ直接流れ込む電荷に対する障壁となり、スミアを抑制する効果があるが、第2のP型ウェル13のパターンがあまり受光領域11へ張り出すと、張り出したP型ウェル13と受光領域11の間で電荷が発生し、垂直転送部15へ漏れ込むため、スミア抑制の効果が低くなる。垂直転送方向に隣接した画素の間は、距離的にあまり余裕がなく、ここに前記したようにP型ウェル13aを設けると、プロセス上の制限から受光領域11に向かって張り出すようになり、このP型ウェル13aが垂直転送部15の第2のP型ウェル13と接続されると、このP型ウェル13aを通してスミア成分の電荷が垂直転送部15へ漏れ込み、スミア特性を劣化させてしまう。

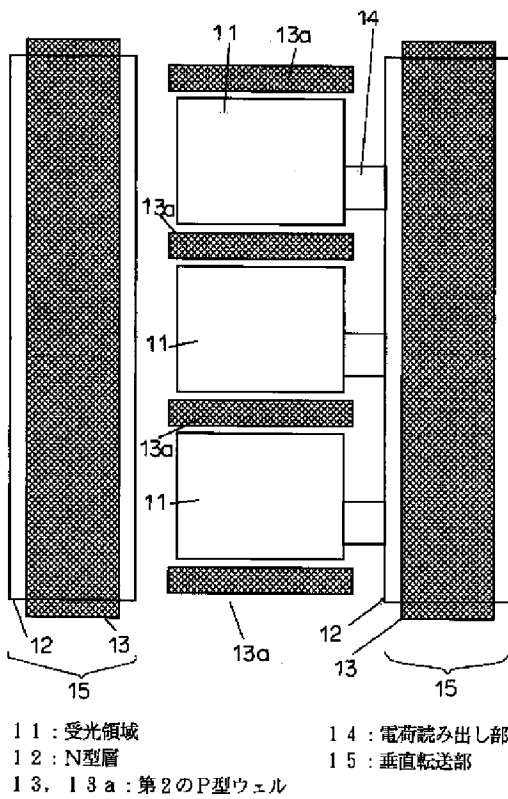
【0014】そこで、この第2の実施形態では、垂直転

11 : 受光領域
13a : 第2のP型ウェル
16 : N型半導体基板
17 : 第1のP型ウェル
17a : P型不純物濃度が低い領域

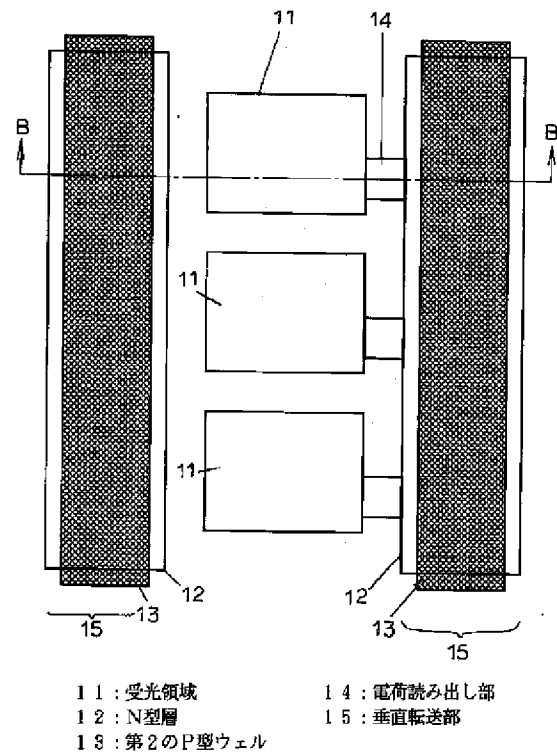
【図3】



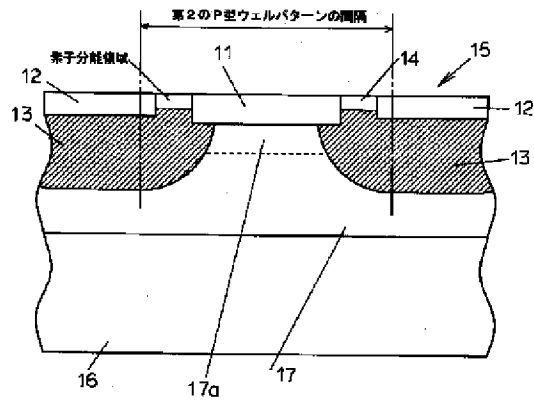
【図4】



【図5】

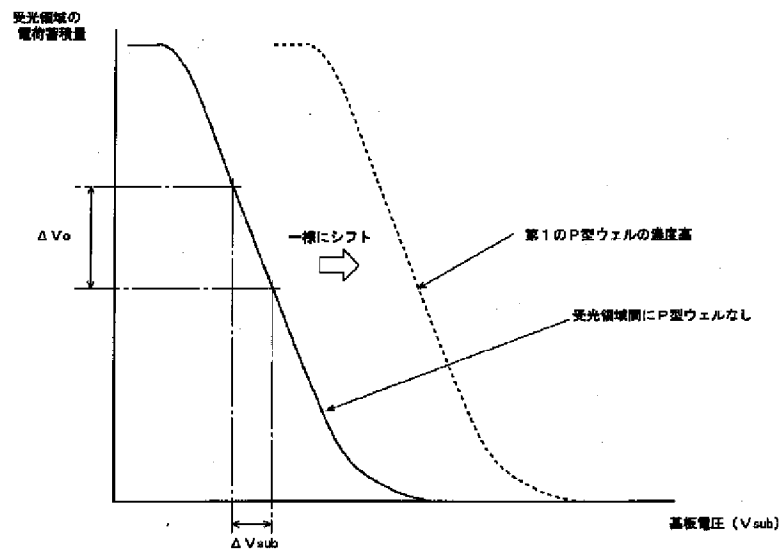


【図6】



- 11 : 受光領域
- 12 : N型層
- 13 : 第2のP型ウェル
- 14 : 電荷読み出し部
- 15 : 垂直転送部
- 16 : N型半導体基板
- 17 : 第1のP型ウェル
- 17a : P型不純物濃度が低い領域

【図7】



【図8】

